



汕头华汕电子器件有限公司

PNP SILICON TRANSISTOR

H1266

对应国外型号
KTA1266

主要用途

作音频电压放大、激励级放大。

极限值 ($T_a=25^\circ\text{C}$)

T_{stg} ——贮存温度.....	-55~150
T_j ——结温.....	150
P_C ——集电极耗散功率.....	400mW
V_{CBO} ——集电极—基极电压.....	-50V
V_{CEO} ——集电极—发射极电压.....	-50V
V_{EBO} ——发射极—基极电压.....	-5V
I_C ——集电极电流.....	-150mA I_C
——集电极电流.....	-50mA

外形图及引脚排列

TO-92



1—发射极, E
2—集电极, C
3—基 极, B

电参数 ($T_a=25^\circ\text{C}$)

参数符号	符 号 说 明	最小值	典型值	最大值	单 位	测 试 条 件
BV_{CBO}	集电极—基极击穿压降	-50			V	$I_C=-100\mu\text{A}$, $I_E=0$
BV_{CEO}	集电极—发射极击穿压降	-50			V	$I_C=-1\text{mA}$, $I_B=0$
BV_{EBO}	发射极—基极击穿压降	-5			V	$I_E=-10\mu\text{A}$, $I_C=0$
I_{CB0}	集电极—基极截止电流			-0.1	μA	$V_{CB}=-50\text{V}$, $I_E=0$
I_{EB0}	发射极—基极截止电流			-0.1	μA	$V_{EB}=-5\text{V}$, $I_C=0$
$H_{FE}(1)$	直流电流增益	70		400		$V_{CE}=-6\text{V}$, $I_C=-2\text{mA}$
$H_{FE}(2)$		25				$V_{CE}=-6\text{V}$, $I_C=-150\text{mA}$
$V_{CE(sat)}$	集电极—发射极饱和压降		-0.1	-0.3	V	$I_C=-100\text{mA}$, $I_B=-10\text{mA}$
$V_{BE(sat)}$	基极—发射极饱和压降			-1.1	V	$I_C=-100\text{mA}$, $I_B=-10\text{mA}$
f_T	特征频率	80			MHZ	$V_{CE}=-10\text{V}$, $I_C=-10\text{mA}$
C_{ob}	输出电容		4	7	pF	$V_{CB}=-50\text{V}$, $I_E=0$, $f=1\text{KHz}$

分档及其标志

O

Y

GR

70—140

120—240

200—400